

2SC828, 2SC828A

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

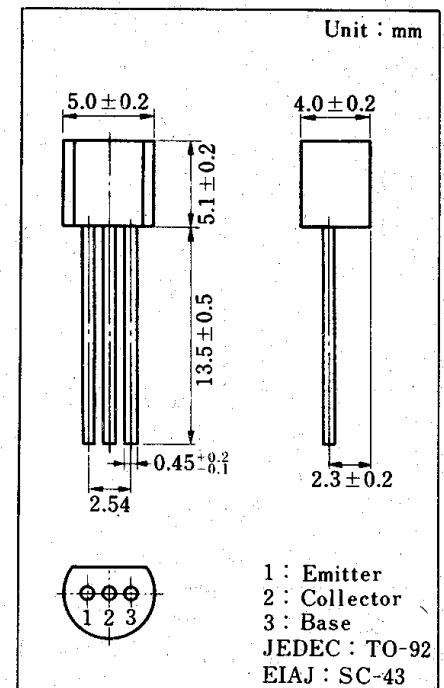
小信号増幅用 / Small Signal Amplifier

■ 特 徴 / Feature

- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。 / High h_{FE}

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
		45	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	25	V
		45	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	100	mA
コレクタ電流	I_C	50	mA
コレクタ損失	P_C	400	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 10 \mu\text{A}, I_E = 0$	30			V
			45			
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 2 \text{ mA}, I_B = 0$	25			V
			45			
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 10 \mu\text{A}, I_C = 0$	7			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 2 \text{ mA}$	130		520	
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = 10 \text{ V}, I_E = -2 \text{ mA}$		220		MHz
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CB} = 5 \text{ V}, I_C = 10 \text{ mA}$			0.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 50 \text{ mA}, I_B = 5 \text{ mA}$		0.14		V
雑音指数	NF	$V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 0.2 \text{ mA}, R_g = 2 \text{ k}\Omega, f = 1 \text{ kHz}$		6		dB

* h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

Class	Q	R	S
h_{FE}	130 ~ 260	180 ~ 360	260 ~ 520